Документ подписан простой электронной подписы МИНИСТ ЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информация о владельце: ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 30.01.2023 16:41:18 Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе магистратуры

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образованию

Волков А.А.

11.04.04

31.08.2022

11.04.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Программа

Технологии микро- и наноэлектроники

магистратуры:

Кафедра: Кафедра технологии материалов электроники

Институт новых материалов и нанотехнологий

Квалификация: Магистр

Форма обучения: Очная форма

Срок получения образования: 2 г.

Год начала подготовки 2022

(по учебному плану)

 Учебный год
 2022-2023

Образовательный стандарт

(СУОС) <u>95 о.в. от 05.03.2020</u>

Код	Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты	
40	СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
40.006	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ	

+	Основной	Типы задач профессиональной деятельности
+	+	научно-исследовательская
+	-	производственно-технологический

Календарный учебный график

Mec	(Сент	ябрь		,	0	итяб	рь	2		Ноя	брь		- 1	Дека	брь			Я	юар	%	_	Фе	epa	пь	,		Ma	рт		,	An	рель		,		Май			И	ОНЬ		S	- 1	Июль		2		Apry	уст	
- August	1 - 7	8 . 34	15 - 23	22 · 38	53	6 - 32	33 - 39	20 - 36	27.	3 - 9	30 . 36	17 - 23	24 - 30	1.7	8 - 34	15 - 21	22 - 28	- 53	17	12 - 38	7	36		9 - 35	16 - 22	- 23	2 · 8	9 - 15	16 - 22	23 - 20	30	6 - 32	13 - 79	20.36		4 . 30	7 - 11	10 - or		. 8	15 - 23	22 - 38	29.	6 - 32	13 - 19	20 - 26	27 -	3 - 9	30 - 36	17 - 23	34-33
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34 3	5 3	36	7 3	8 3	9 40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51 !	52
I																			Э	Э	Э	K	K																		Э	Э	У	У	У	У	K	K	K	K	K
п													•	•						Э	Э	Э	К	К	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	1 1	п	1 [1 4	Д	Д	Д	Д	Д	K	K	K	K	K	K	K	K

Сводные данные

			Курс 1			Курс 2		Итого
		Сем. 1	Cen. 2	Boero	Cen. 3	Cen. 4	Boero	итого
	Теоретическое обучение и практики	18	18	36	19		19	55
Э	Экзаменационные сессии	3	2	5	3		3	8
У	Учебная практика		4	4				4
П	Производственная практика					14	14	14
Д	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы					6	6	6
К	Каникулы	2	5	7	2	8	10	17
(не в	олжительность обучения ключая нерабочие праздничные дни никулы)	60.	пее 39 н	ед.	60.	лее 39 н	ед.	
Ито	го	23	29	52	24	28	52	104
Сту	дентов							
Груг	nn		·				·	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Учебный план магистратуры '11.04.04-МЭН-22-3.plx', код направления 11.04.04, программа магистратуры: 3, год начала подготовки 2022

Индекс	Наименование	Формируемые компетенции
1	Дисциплины (модули)	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Б1.О	Обязательная часть	УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5
Б1.О.01	Методы математического моделирования	УК-1; ОПК-2; ОПК-3
Б1.О.02	История и методология науки и техники в области электроники	УК-5; УК-6; ОПК-1
Б1.О.03	Основы предпринимательства	УК-2; УК-3; ОПК-5
Б1.О.04	Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники	УК-1; ОПК-1
Б1.О.05	Компьютерные технологии в научных исследованиях	УК-1; ОПК-4
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений	УК-1; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Б1.В.01	Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур	УК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-3
Б1.В.02	Метрология, стандартизация и сертификация наноструктур	УК-1; ОПК-2; ПК-4
Б1.В.03	Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная технологии	УК-1; ОПК-2; ПК-3
Б1.В.04	Радиационно-технологические процессы в электронике	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4
Б1.В.05	Физика квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций	УК-1; ОПК-1; ПК-4
Б1.В.06	Приборы и устройства на основе наносистем	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4
Б1.В.07	Проектирование и технология электронной компонентной базы	УК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3
Б1.В.08	Неразрушающие методы контроля процессов формирования гетерокомпозиций	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4
Б1.В.ДВ.01	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4
Б1.В.ДВ.01.01	Элионная технология в микро- и наноиндустрии	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4
Б1.В.ДВ.01.03	Приборы и устройства магнитоэлектроники	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4
Б1.В.ДВ.02	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-3
Б1.В.ДВ.02.01	Высоковакуумное оборудование в наноэлектронике	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-3
Б1.В.ДВ.02.02	Технология материалов экстремальной электроники	УК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-3
Б1.В.ДВ.03	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3	УК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3
Б1.В.ДВ.03.01	Конструирование светоизлучающих устройств	УК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3
Б1.В.ДВ.03.02	Конструирование фотопреобразователей	УК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-3
Б1.В.ДВ.04	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4	УК-4; ПК-4
Б1.В.ДВ.04.01	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)	УК-4; ПК-4
Б1.В.ДВ.04.02	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык	УК-4; ПК-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Учебный план магистратуры '11.04.04-МЭН-22-3.plx', код направления 11.04.04, программа магистратуры: 3, год начала подготовки 2022

Индекс	Наименование	Формируемые компетенции
Б1.В.ДВ.04.03	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)	УК-4; ПК-4
Б1.В.ДВ.05	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5	УК-1; ОПК-1; ПК-3; ПК-4
Б1.В.ДВ.05.01	Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы)	УК-1; ОПК-1; ПК-3; ПК-4
Б1.В.ДВ.05.02	Термодинамика и микротехнология многокомпонентных гетероструктур	УК-1; ОПК-1; ПК-3; ПК-4
Б1.В.ДВ.06	Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6	
52	Практика	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б2.О	Обязательная часть	
52.B	Часть, формируемая участниками образовательных отношений	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б2.В.01(У)	Научно-исследовательская практика	УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-3; ПК-4
Б2.В.02(Н)	Научно-исследовательская работа	УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
Б2.B.03(П)	Педагогическая практика	УК-3; ПК-5
Б2.В.04(П)	Преддипломная практика	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4
53	Государственная итоговая аттестация	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
ртд	Факультативные дисциплины	ΠK-4
ФТД.01	Методы исследования материалов	ПК-4
ФТД.02	Технологии получения материалов	ПК-4

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОФ.СТАНД	ДАРТОВ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ Учебный план магистратуры '11.04.04-МЭН-22-3.plx', код направления 11.04.04, программа магистратуры: 3, год начала по,
Индекс	Содержание
ПК-1	Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство
40.006	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
	Разработка и внедрение современных технологических процессов, освоение нового оборудования, технологической оснастки, необходимых режимов

40.006	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
В	Разработка и внедрение современных технологических процессов, освоение нового оборудования, технологической оснастки, необходимых режимов производства на выпускаемую организацией продукцию
B/01.7	Разработка технологических процессов и внедрение их в производство
ТД.1	Расчет режимов технологического процесса для конкретной технологии
ТД.2	Осуществление тестового запуска, технологического сопровождения и контроля экспериментальной партии
ТД.3	Осуществление поэтапного контроля технологических и электрофизических параметров изготавливаемого изделия
У.1	Владеть методами сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-технической информации
У.2	Измерять электрофизические параметры формируемых слоев и изделий
У.3	Проводить анализ и определять причины отклонения параметров
У.4	Производить расчеты режимов технологических операций
У.5	Оптимизировать параметры технологических процессов
У.7	Планировать и проводить технологические эксперименты
У.9	Разрабатывать технологические маршруты (маршрутные карты)
3н.1	Технический английский язык
3н.7	Основы физики наноразмерных пленок
3н.9	Теория планирования эксперимента и обработки данных
3н.12	Базовые технологические процессы и маршруты наноэлектроники
3н.13	Методы физико-технологического моделирования
3н.16	Методы исследования структур
3н.18	Мировой опыт развития технологических процессов изготовления наноэлектронного изделия; опыт разработки наноэлектронной элементной базы издели
K-2	Способность оптимизировать параметры технологических операций
40.006	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
В	Разработка и внедрение современных технологических процессов, освоение нового оборудования, технологической оснастки, необходимых режимов производства на выпускаемую организацией продукцию
B/02.7	Оптимизация параметров технологических операций
ТД.2	Расчет режимов выполнения технологической операции
ТД.4	Поэтапный контроль технологических и электрофизических параметров контрольных пластин
ТД.5	Тестирование экспериментального образца изделия
ТД.6	Корректировка технологических режимов по результатам тестирования (при необходимости)
У.3	Работать на технологическом оборудовании (выполнять все действия, которые делает оператор)
У.4	Разрабатывать технологические рецепты для технологического оборудования
У.5	Разрабатывать операционные карты
У.6	Разрабатывать элементную базу изделия (операционные, маршрутные и контрольные карты)
3н.1	Технический английский язык
3н.6	Теория планирования эксперимента и обработки данных
3н.9	Базовые технологические процессы наноэлектроники

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОФ.СТАНДАРТОВ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ Учебный план магистратуры '11.04.04-МЭН-22-3.plx', код направления 11.04.04, программа магистратуры: 3, год начала по,

Индекс	Содержание
3н.13	Методы исследования структур
ПК-3	Способность проводить экспериментальные работы и осваивать новые технологические процессы
40.006	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
В	Разработка и внедрение современных технологических процессов, освоение нового оборудования, технологической оснастки, необходимых режимов производства на выпускаемую организацией продукцию
B/04.7	Экспериментальные работы и освоение новых технологических процессов
ТД.1	Разработка новых технологических процессов
тд.2	Обоснование экономической целесообразности их внедрения
У.1	Определять экономическую целесообразность внедрений новых технологий и процессов
3н.1	Предназначение, современные виды оборудования для проведения анализа и измерений параметров наноразмерных объектов

КУРО	C 1 Учебный план	магистратуры '11.04.04-МЭН-22-3.plx', код напр	равления 1	11.04.0	.4, прог <u>г</u>	рамма	магист	гратурі	ы: 3, го	од начал	а поді	готовки 20	22																					
				_			Семе										Семес											за кур						
	'	!	1	<u> </u>	^	Академи	т пически	их часс	ОВ					ļ	A	кадеми	иески:	х часо	В		4	i '		<u> </u>		4каде≀ Т	мическ	их часс)B		з.е.	.		
Nº	№ Индекс	Наименование	Контроль	Всего	го Кон такт.		Лаб	Пр	СР	Контро ль	з.е.	Недель	Контроль	Bcero	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	CP I	Контро ль	3.e.	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контро ль	Bcero	Недель	Каф.	Семестр
_	ОГО (с факультатив	,		1080	١						30	21		1296						. H	36	24		2376							66	45		
ИТ	ИТОГО по ОП (без факультативов)		4'	1080							30			1080							30	- '		2160	<u> </u>						60	,,,		
		ОП, факультативы (в период ТО)	4 '	51										54	1									52.5	1								l	ı
	, , , , , ,	ОП, факультативы (в период экз. сес.)	A '	54										54	ł									54	ł								ı	i
(an		Аудиторная нагрузка Контактная работа	A '	13.3										13.3										13.3	l								l	·
n.				1080		3 51	68	119	680	162	30	TO: 18			254	85	51	118	710	108	30	TO: 18			492	126	119	237	1398	270	60	TO: 36		
	1 1	ОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ	Эк КР	180				119	93	36	5	Э: 3		1000	254	65	51	110	/10	100	30	Э: 2	Эк КР	180	51	17		17			5	Э: 5	27	1
2	51 0 02	Методы математического моделирования История и методология науки и техники в области электроники	3aO	144				34	110	30	4				\sqcap	\sqcap	+	\dashv	\dashv				3aO	144	34	17	17	34	93 110	36	4		27	1
3	51 0 04	Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники	Эк	180	34	+	\square	34	92	54	5				\sqcap	\sqcap	+	\exists	\Box				Эк	180	34			34	92	54	5		27	1
4		Компьютерные технологии в научных исследованиях											3aO	108	34			34	74		3		3aO	108	34			34	74		3		23	2
5	Б1.В.01	Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур	Эк	180	51	<u></u> '	34	17	93	36	5												Эк	180	51		34	17	93	36	5		23	1
6	D1.D.U2	Метрология, стандартизация и сертификация наноструктур				⊥'	<u> </u>	Ĺ_'					3aO	144	34	17		17	110		4		3aO	144	34	17		17	110		4		27	2
7	B1.B.03	Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная технологии			4	<u> </u> '	<u></u> —'	<u> </u>					Эк	144	34	17	17		56	54	4		Эк	144	34	17	17	<u> </u>	56	54	4		27	2
8	D1.B.U4	Радиационно-технологические процессы в электронике			4_	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				3aO	108	51	17	17	17	57		3		3aO	108	51	17	17	17	57		3		25	2
9		Физика квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций	Эк КР	180	34	17	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	17	110	36	5				\bigsqcup	\sqcup	\perp	\dashv					Эк КР	180	34	17		17	110	36	5	. !	27	1
10) 51.B.08	Неразрушающие методы контроля процессов формирования гетерокомпозиций						'					3a	108	51	17	17	17	57		3		За	108	51	17	17	17	57		3		27	2
11	Б1.В.ДВ.03.01	Конструирование светоизлучающих устройств	3aO KP			\perp			110		4												3aO KP	144	34	17	17		110		4		27	1
12	2 Б1.В.ДВ.03.02	Конструирование фотопреобразователей	3aO KP	144	4 34	17	17	<u></u> '	110	\vdash	4				igsquare	\longrightarrow	\dashv	\dashv	\rightarrow	\longrightarrow			3aO KP	144	34	17	17	<u> </u>	110	<u> </u>	4		27	1
13		Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы)											Эк	144	34	17		17	56	54	4		Эк	144	34	17		17	56	54	4		27	2
14		Термодинамика и микротехнология многокомпонентных гетероструктур				\perp '							Эк	144	34	17		17	56	54	4		Эк	144	34	17		17	56	54	4		27	2
15		Научно-исследовательская работа	3aO	72	4	<u></u> — '	Щ'	<u> </u>	72	<u> </u>	2		3aO	108	ليبا	$\vdash \vdash$	_		108		3		3aO(2)	180	\sqcup	<u> </u>		<u> </u>	180	<u> </u>	5	. !	27	123
_		Методы исследования материалов			4	+-'	 -	<u> </u>	igspace	\vdash			3a	108	8	\vdash	\dashv	8	100	\longrightarrow	3		3a	108	8	<u> </u>	\perp	8	100	-	3	4 !	27	2
_	7 ФТД.02 ОРМЫ КОНТРОЛЯ	Технологии получения материалов			4	34	(4) 35(O(3) KP	0(3)				3a	108	8	34/2	1) 33(3)	8 3) 3aO(4	100		3		3a	108	8		3"	8	100	(7) KP(3)	3		27	2
			=	=	#		T 3aU	7(3) KF	(3) T	_					_	JK(2) Ja(J)			_					_	=		(0) 3a(7) KF(3)	_		_	
ПР	РАКТИКИ Б2.В.01(У)	(План) Научно-исследовательская практика		+	H	#	-	-	\vdash				3aO	216 216	-				216 216		6	4	3aO	216 216		_			216 216		6	4	27	2
F0		итоговая аттестация (План)		=	十	#							- 000	210		=			210			7	0.0	210					210			7		
		итоговая аттестации (план)	=		#	4		_				2									=		l										_	
KA	НИКУЛЫ											2					—	—	—			5										7		

КУРС 2 Учебный план	магистратуры '11.04.04-МЭН-22-3.plx', код нап	равления	11.04.04	, прогр	амма м	агистра	туры: 3	, год нач	ала по,	дготовки	2022																			
					C	Семестр	3							Сем	естр 4	1							ı	∕1того за к	урс					
				Ак	адемич	еских ч	асов						Акад	демичес	ских ча	асов						Ак	адеми	ических ча	сов		з.е.			
№ Индекс	Наименование																											1	Каф.	Семестр
		Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб П	CP	Контро ль	3.e.	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек Ла	аб Пр	CP	Контро	з.е.	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб Пр	CP	Контр	Всего	Недель		
				iani.				,,,,					I aki.				716					I aki.				110				
ИТОГО (с факультати	вами)		1080						30	22		1080						30	20		2160						60	42		
ИТОГО по ОП (без фа	культативов)		1080						30	22		1080						30	20		2160						60	42		
	ОП, факультативы (в период ТО)		51.2																		25.6									
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,	ОП, факультативы (в период экз. сес.)		36																		18									
(акад.час/нед)	Аудиторная нагрузка		9.9																		5									
	Контактная работа		9.9																		5									
дисциплины (мо	ДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ		1080	187	85	17 8	785	108	30	TO: 19 9: 3									ТО: Э:		1080	187	85	17 85	785	108	30	TO: 19 9: 3		
1 51.0.03	Основы предпринимательства	3aO	108	34	17	17	7 74		3											3aO	108	34	17	17	74		3		31	3
2 61.B.06	Приборы и устройства на основе наносистем	Эк	144	34	17	17	7 74	36	4											Эк	144	34	17	17	74	36	4		27	3
3 61.B.07	Проектирование и технология электронной компонентной базы	3aO	108	34	17	17	7 74		3											3aO	108	34	17	17	74		3	1	25	3
4 Б1.В.ДВ.01.01	Элионная технология в микро- и	Эк	144	34	17	17	7 74	36	4											Эк	144	34	17	17	74	36	4	İ	27	3
	наноиндустрии	_																	1									1		
5 Б1.В.ДВ.01.03	Приборы и устройства магнитоэлектроники	Эк	144	34	17	17	7 74	36	4							-				Эк	144	34	17	17	74	36	4		27	3
6 Б1.В.ДВ.02.01	Высоковакуумное оборудование в наноэлектронике	Эк	180	34	17	17	110	36	5							\perp				Эк	180	34	17	17	110	36	5		27	3
7 Б1.В.ДВ.02.02	Технология материалов экстремальной электроники	Эк	180	34	17	17	110	36	5											Эк	180	34	17	17	110	36	5		27	3
8 Б1.В.ДВ.04.01	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)	3aO	108	17		17	7 91		3											3aO	108	17		17	91		3		27	3
9 <i>Б1.В.ДВ.04.02</i>	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык	3aO	108	17		17	91		3											3aO	108	17		17	91		3		27	3
10 <i>Б1.В.ДВ.04.03</i>	Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)	3aO	108	17		17	7 91		3											3aO	108	17		17	91		3		27	3
11 52.B.02(H)	Научно-исследовательская работа	3aO	72				72		2											3aO	72				72		2		27	123
12 Б2.Β.03(Π)	Педагогическая практика	3aO	216				216		6											3aO	216				216	3	6		27	3
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ					Эн	(3) 3aO((5)																	3	ж(3) 3	aO(5)				
ПРАКТИКИ	РАКТИКИ (План)											756				756		21	14		756				756	5	21	14		
52.B.04(Π)	Б2.В.04(П) Преддипломная практика										3aO	756				756		21	14	3aO	756				756	5	21	14	27	4
государственная	итоговая аттестаци: (План)											324				324		9	6		324				324	1	9	6		
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы											324				324		9	6		324				324	1	9	6	27	4
КАНИКУЛЫ										2									8									10		